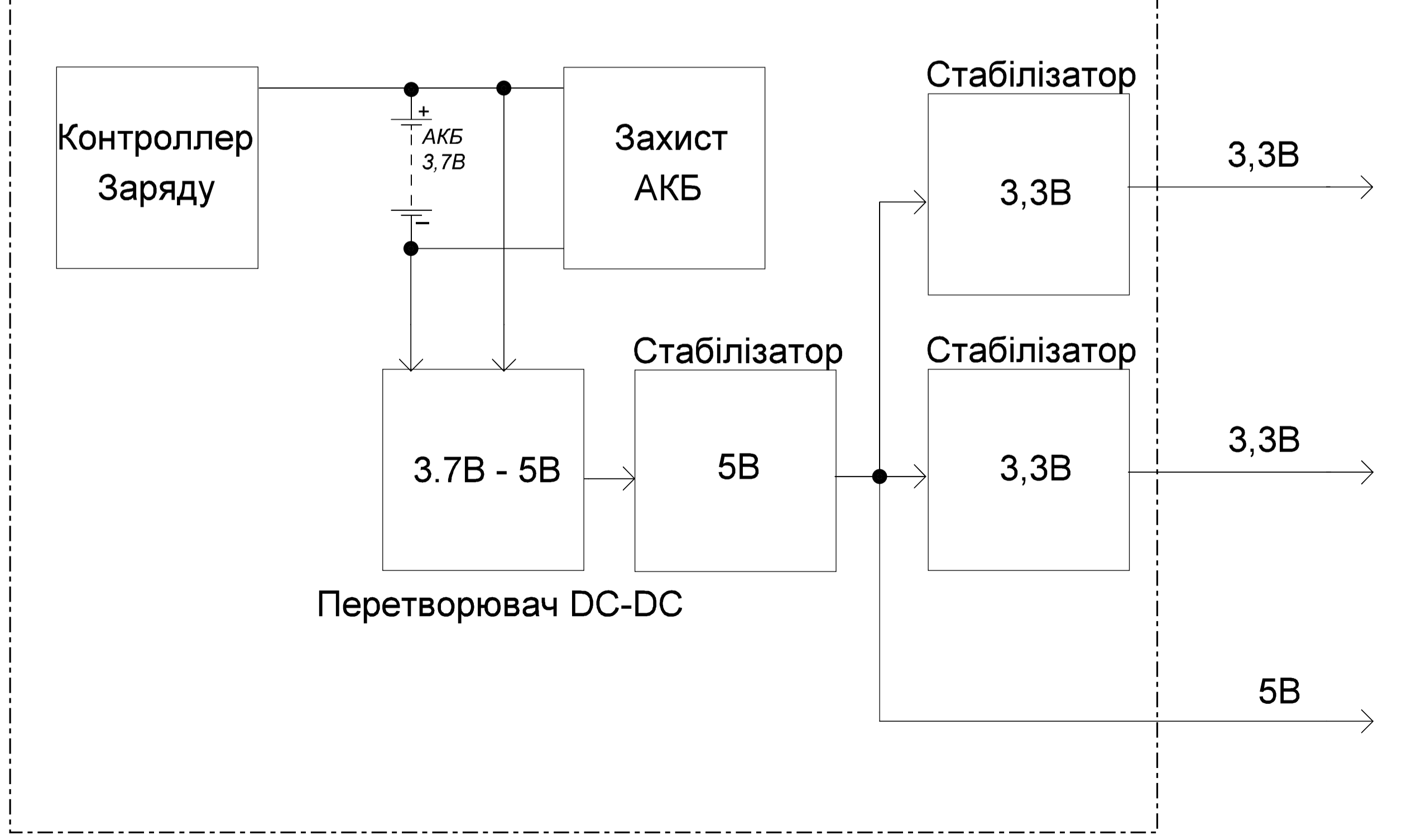
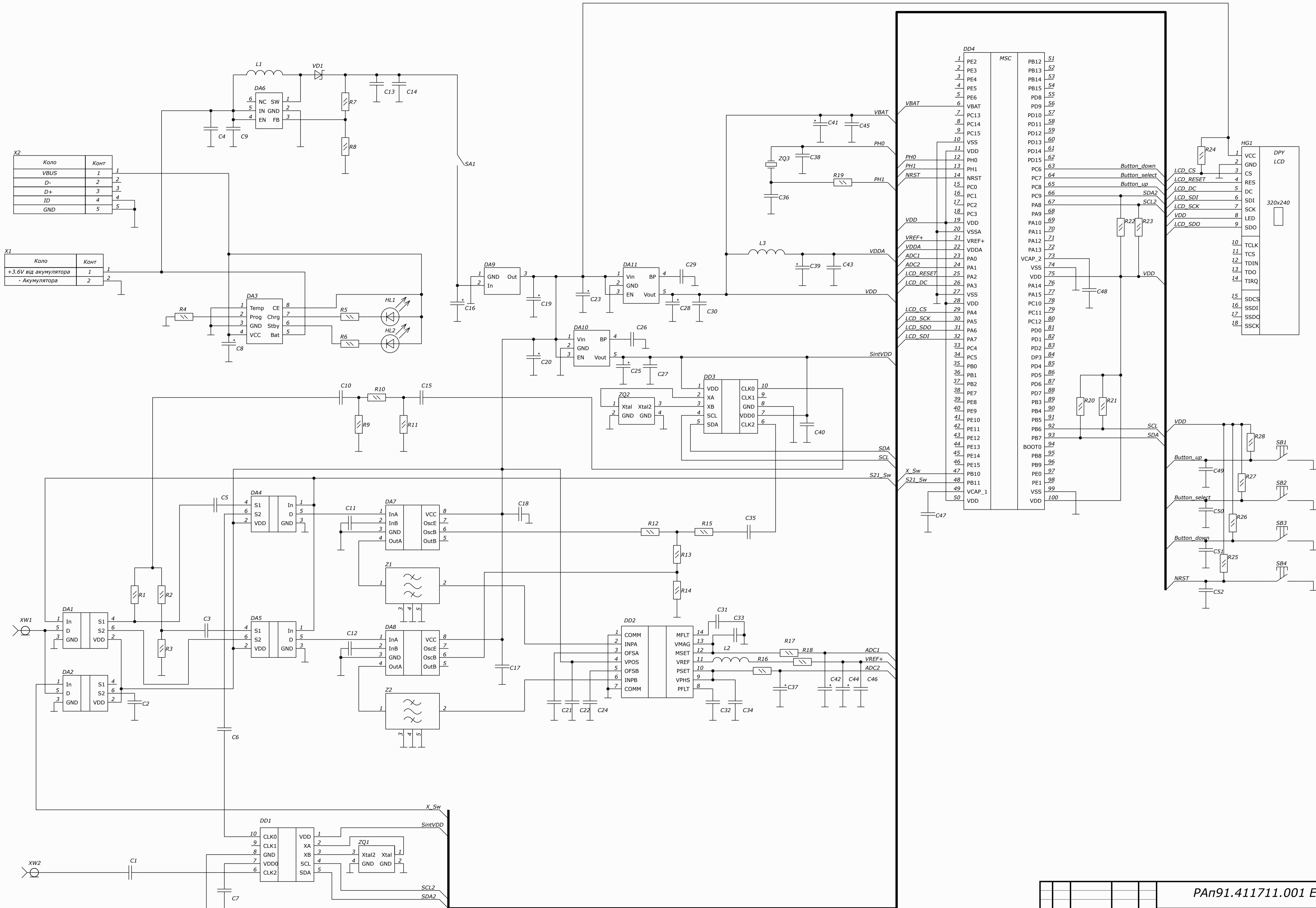


Блок живлення



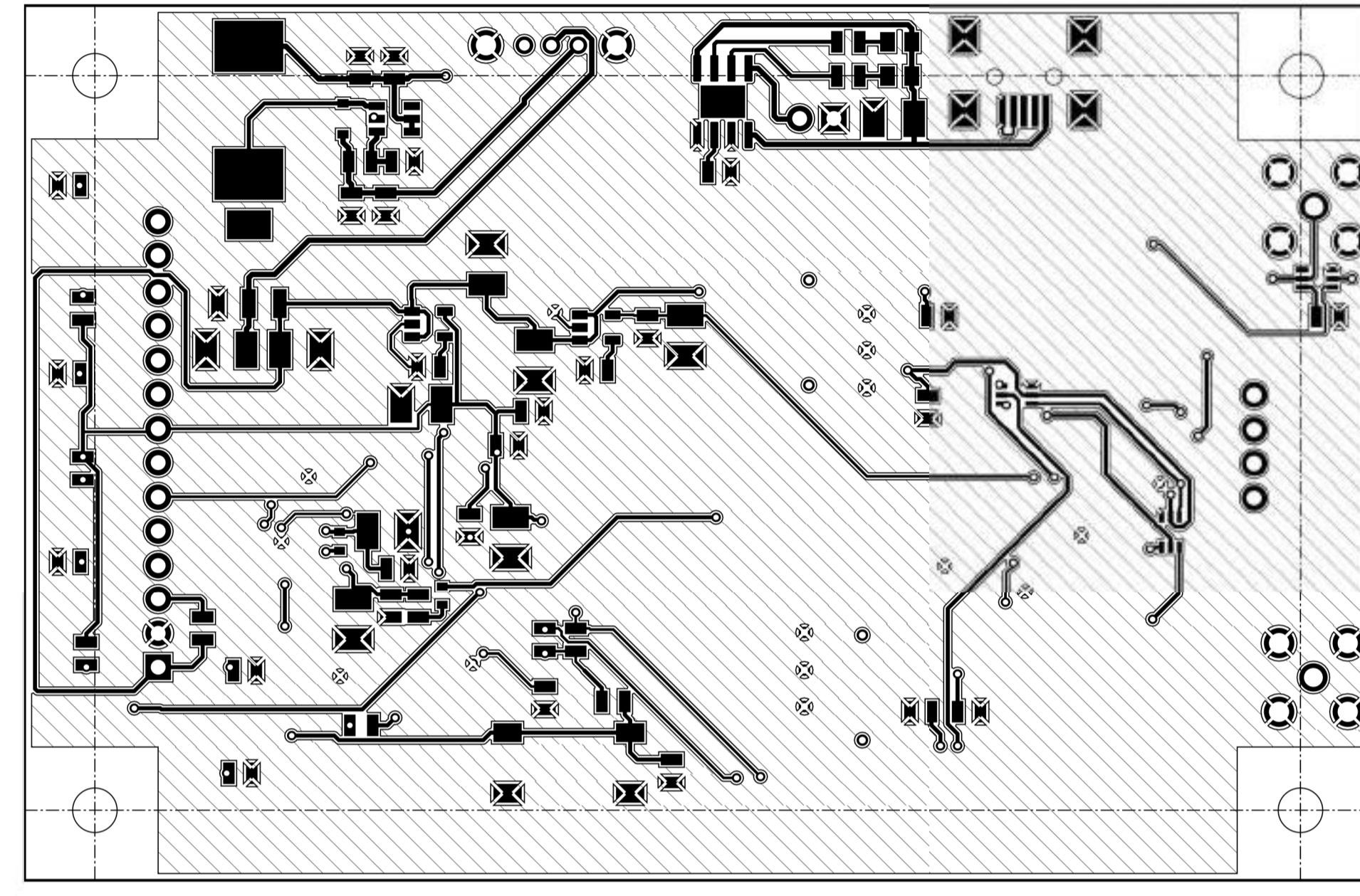
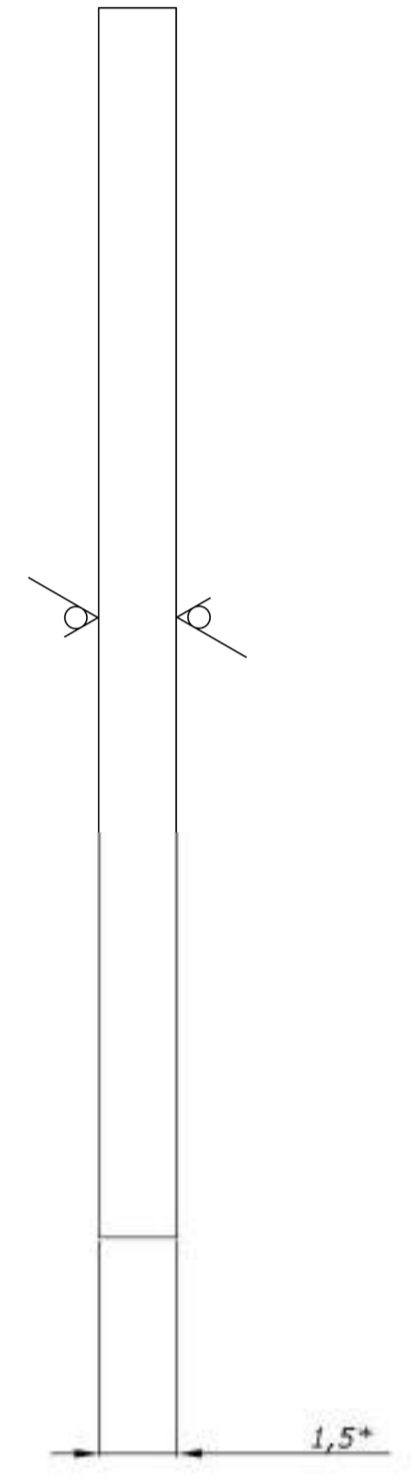
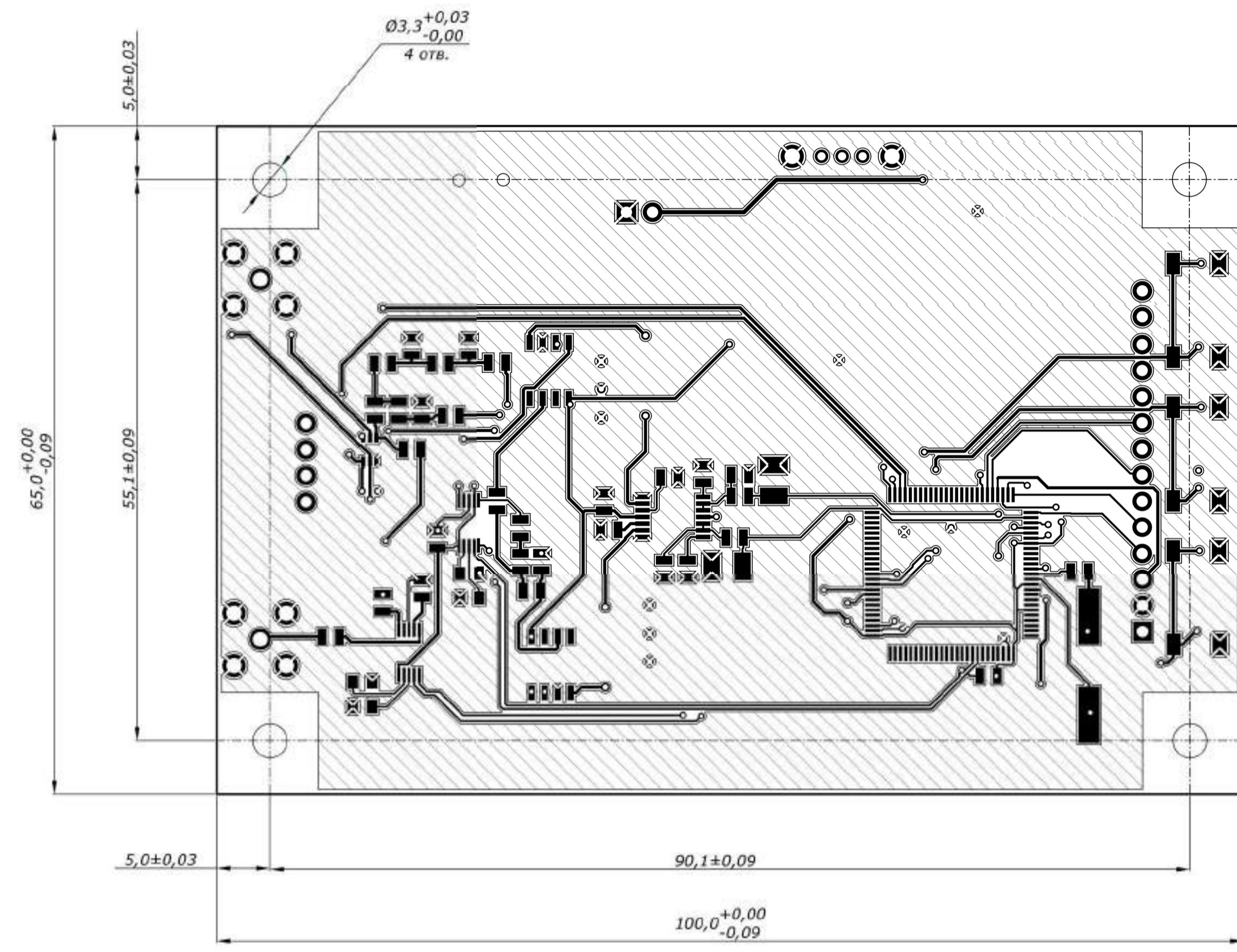
					РАп91.411711.001 Е1			
Зм	Арх	№ докум.	Підпис	Дата	Панорамний векторний аналізатор Схема електрична структурна	Літ	Маса	Масштаб
Розробив	Аристов А.М.							
Перевірив						Аркуш 1	Аркуше 1	
Т. контр.								
Реценз.								
Н. контр.	Полсуй В.І.				КПІ, РТФ, РА-п91			
Зате	Дюжаєв Л.П.				Копіював Формат			



Коло	Конкт
VBUS	1
D-	2
D+	3
ID	4
GND	5

Коло	Конкт
+3.6V від акумулятора	1
- Акумулятора	2

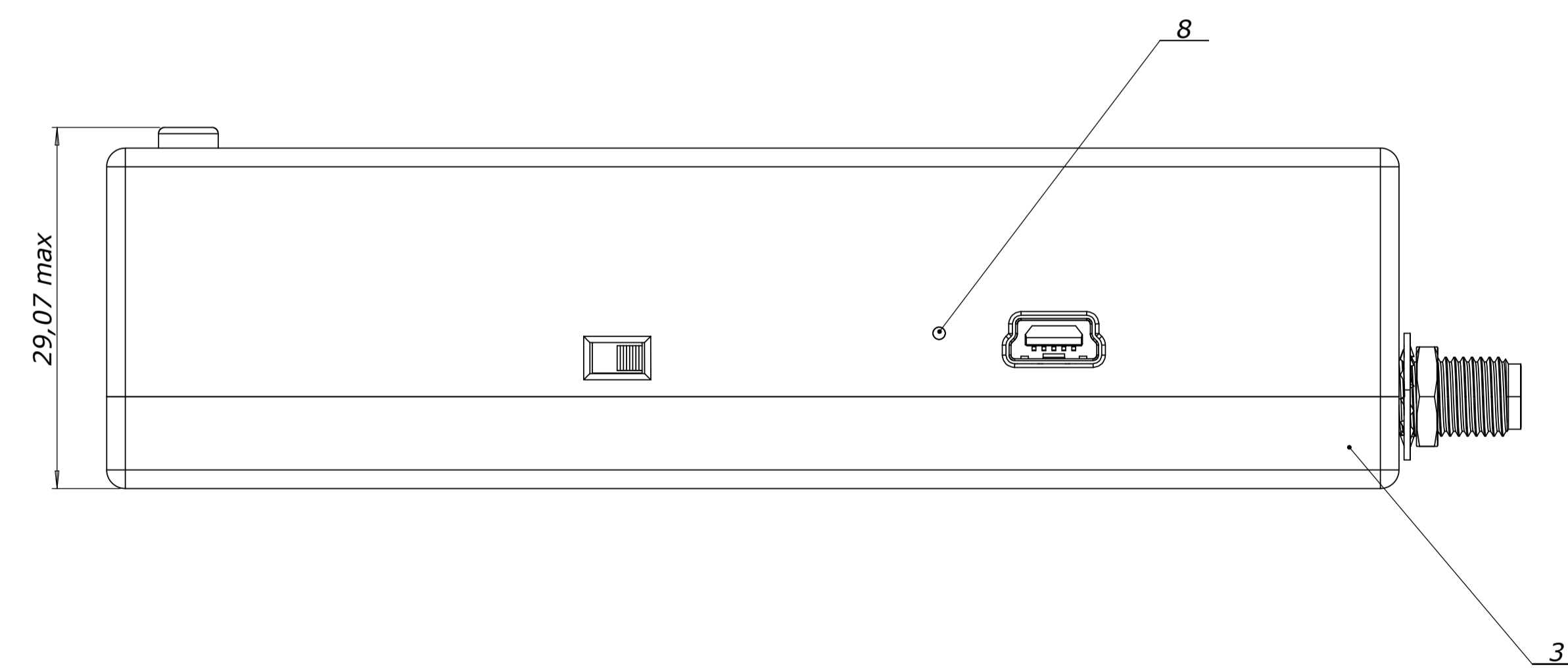
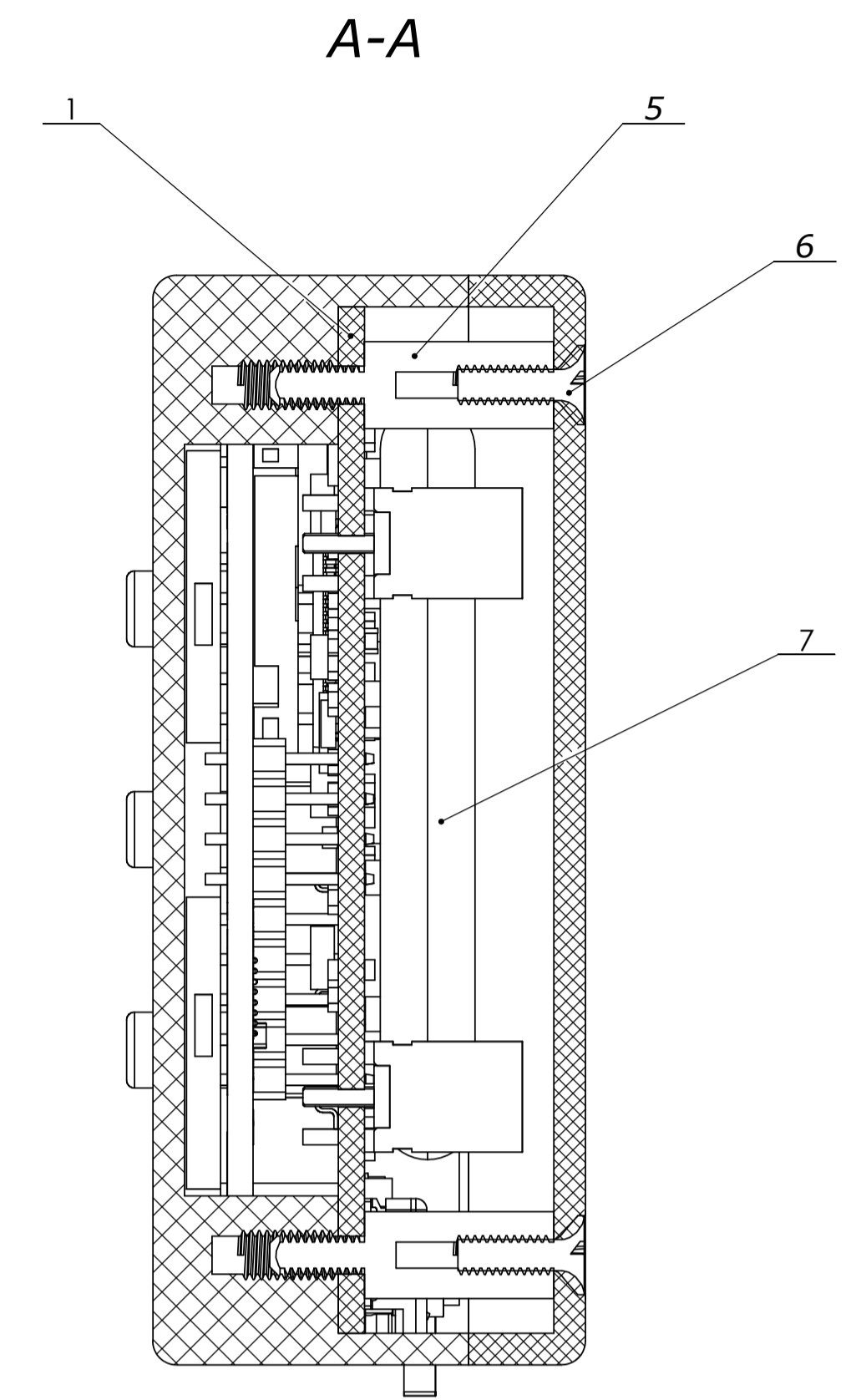
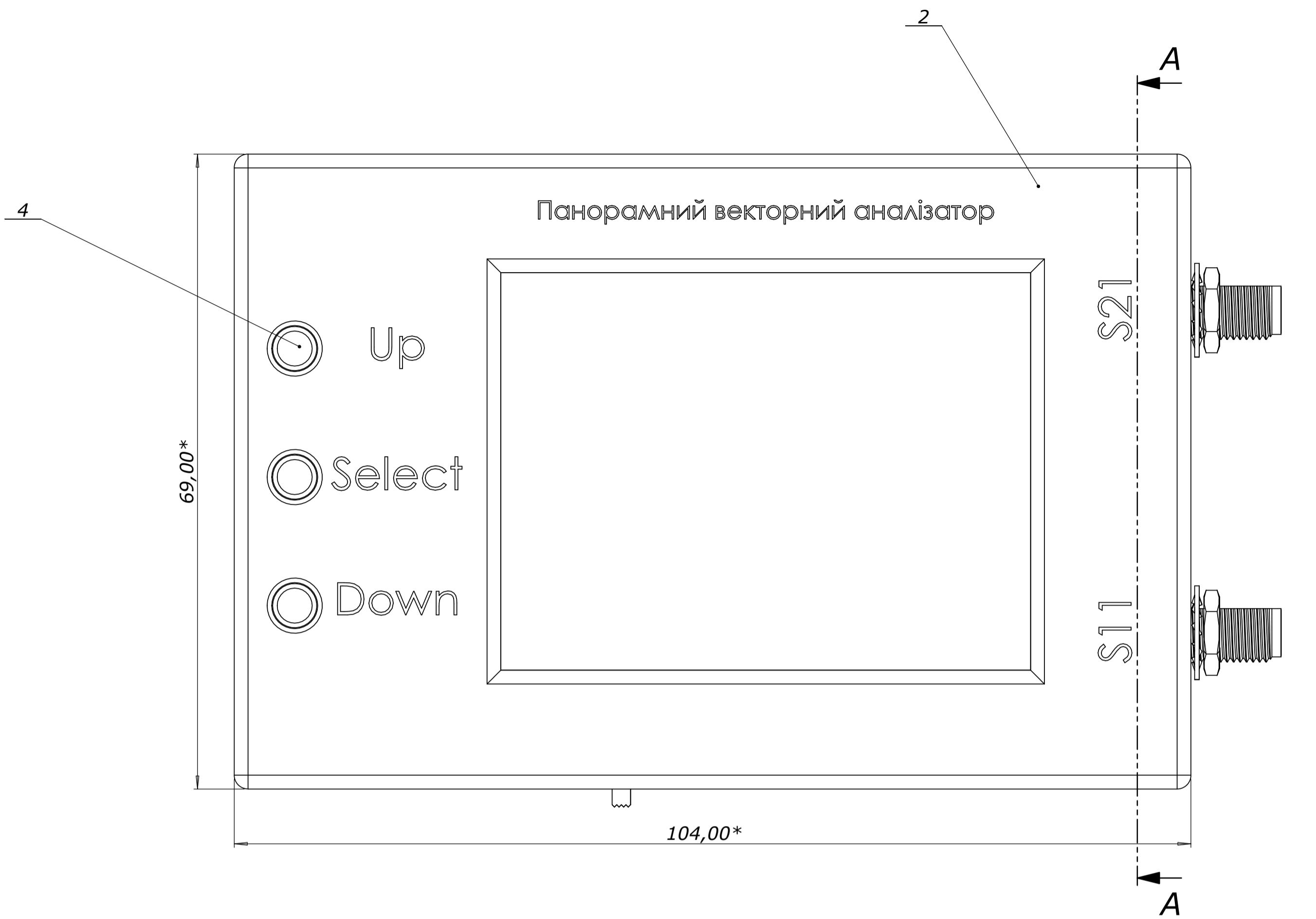
РАп91.411711.001 ЕЗ				Лит.	Маса	Масштаб
Зм. Лист	№ докум.	Підпис	Дата	Панорамний векторний аналізатор		
Розроб.	Аристов А.А.	<i>[Signature]</i>		Схема електрична принципова		
Л. контр.				Лист 1	Листів 1	
Н. контр.	Попсуй В.І.	<i>[Signature]</i>		РТФ, КПІ, РА-п91		
Затв.	Дюжаєв Л.П.	<i>[Signature]</i>		Копіював: Формат А1		



1. * Розміри для довідок
2. Плату виготовити комбінованим негативним методом
3. Клас точності 4 за ГОСТ 23751-86
4. Координати отворів друкованої плати у файлі Drill.Cam
 Топологія верхнього шару металізації друкованого шару у файлі TL.Cam
 Топологія нижнього шару металізації друкованого шару у файлі BL.Cam
 Верхня захисна маска у файлі TS.Cam
 Нижня захисна маска у файлі BS.Cam
 Топологія верхнього шару шовкографії у файлі TO.Cam
 Топологія нижнього шару шовкографії у файлі BO.Cam
5. Інші технічні вимоги по ОСТ4 Г0.010.070.014

				PAп91.758725.001				
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	Плата Панорамного векторного аналізатора	Літ.	Мес.	Масштаб
Розроб.	Перев.	Т. контр.	Н. контр.	Затв.		Лист	1	Листів
					FR4 70/70 1,5 ISO9001:2008	КПІ, РТФ, РА-п91		
				Копіював		Формат А1		

Лист № 1 з 1
 Справ. №
 Перш. застос.
 Підп. та дата
 Ім'я, № події
 Взам. ім'я, № Імв. № події
 Ім'я, № події





- 1. *Розміри для довідок
- 2. Монтаж проводиться згідно схеми електричної принципової РАп91.411711.001 ЕЗ
- 3. Інші вимоги по ОСТ4.ГО.070.0



				РАп91.411711.001 СК			
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	Літ.	Маса	Масштаб
Розроб.	Аристов						2.5:1
Перев.							
Т. контр.					Лист 1	Листів 1	
Н. контр.	Попсуй				КПІ, РТФ, РА-п91		
Затв.	Дюжаєв						
1 Копіював							Формат А1

Лист № докум. | Підп. та дата | Взам. інв. № | Інв. № дубл. | Підп. та дата | Стр. № | Перш. застосує.

Позн.	Найменування	Кіл.	Примітки
	<u>Конденсатори</u>		
C1	CC0805JR9BB101-YAGEO 100 нФ 50 В ±5%	1	
C2	CC0805JR9BB100-YAGEO 10 нФ 50 В ±5%	1	
C3-C6	CC0805JR9BB101-YAGEO 100 нФ 50 В ±5%	4	
C7,C27,C30	CC0805JR9BB474-YAGEO 0.47 мкФ 50 В ±5%	3	
C8,C25,C28	TAJB106K016RNJ-AVX 10 мкФ 16 В ±10%	3	
C9,C37,C39	TAJB105K016RNJ-AVX 1 мкФ 16 В ±10%	3	
C10-C13, C15	CC0805JR9BB101-YAGEO 100 нФ 50 В ±5%	5	
C14	CC0805JR9BB104-YAGEO 100 нФ 50 В ±5%	1	
C16,C19,C20	TAJB476K016RNJ-AVX 47 мкФ 16 В ±10%	3	
C17-C18	CC0805JR9BB104-YAGEO 100 нФ 50 В ±5%	2	
C21,C22,C24	CC0805JR9BB104-YAGEO 100 нФ 50 В ±5%	3	
C23	TAJB476K016RNJ-AVX 47 мкФ 16 В ±10%	1	
C26,C29	CC0805JR9BB223-YAGEO 22 нФ 50 В ±5%	2	
C31-C34	CC0805JR9BB104-YAGEO 100 нФ 50 В ±5%	4	
C35	CC0805JR9BB101-YAGEO 100 нФ 50 В ±5%	1	
C36,C38	CC0805JR9BB200-YAGEO 20 нФ 50 В ±5%	2	
C40	CC0805JR9BB474-YAGEO 0.47 мкФ 50 В ±5%	1	
C41,C42,C44	TAJB105K016RNJ-AVX 1 мкФ 16 В ±10%	3	
C43,C45,C46	CC0805JR9BB104-YAGEO 100 нФ 50 В ±5%	3	
C47,C48	CC0805JR9BB225-YAGEO 2.2 мкФ 50 В ±5%	2	
C49-C52	CC0805JR9BB104-YAGEO 100 нФ 50 В ±5%	4	

РАn91.411711.001 ПЕ				
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата
Розробив		Аристов		
Перезір.				
Реценз.				
Н. Контр		Полсуй		
Затверд.		Дюжаєв		
Панорамний векторний аналізатор			Літ.	Арк.
Перелік елементів				1
КПІ, РТФ, РА-n91			Аркушів	3

Форм.	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.
				CC0805JR9BB474 0.47 мкФ 50 В ±5%	1	C40
				CC0805JR9BB104 100 нФ 50 В ±5%	1	C14
				CC0805JR9BB104 100 нФ 50 В ±5%	2	C17-C18
				CC0805JR9BB104 100 нФ 50 В ±5%	3	C21,C22, C24
				CC0805JR9BB104 100 нФ 50 В ±5%	4	C31-C34
				CC0805JR9BB104 100 нФ 50 В ±5%	3	C43,C45, C46
				CC0805JR9BB104 100 нФ 50 В ±5%	4	C49-C52
				CC0805JR9BB223 22 нФ 50 В ±5%	2	C26,C29
				CC0805JR9BB101 100 нФ 50 В ±5%	1	C1
				CC0805JR9BB101 100 нФ 50 В ±5%	4	C3-C6
				CC0805JR9BB101 100 нФ 50 В ±5%	5	C10-C13, C15
				CC0805JR9BB101 100 нФ 50 В ±5%	1	C35
				CC0805JR9BB200 20 нФ 50 В ±5%	2	C36,C38
				CC0805JR9BB100 10 нФ 50 В ±5%	1	C2
				<u>Мікросхеми</u>		
				STM32F407VET6	1	DD4
				AMS1117-5	1	DA9
				SA612	2	DA7,DA8
				AD8302	1	DD2
				SI5351	2	DD1,DD3
				MT3608	1	DA6
				PA91.411711.002		3
Зм	Акр	№ докум.	Підп	Дата		

Форм.	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.
				<u>Документація</u>		
A4			РAn91.411711.001 ПЗ	Пояснювальна записка		
A1			РAn91.411711.001 СК	Складальне креслення		
				<u>Складальні одиниці</u>		
		1	РAn91.758725.001	Друкована плата	1	
				<u>Деталі</u>		
		2		Корпус	1	
		3		Кришка	1	
		4		Поршні кнопки	3	
		8		Вставка з прозорого пластику	1	
				<u>Інші вироби</u>		
		5		Стійка KLS8-0214-M3-12	4	
		6		Гвинт М3х8 DIN EN ISO 7046-1	4	
		7		Акумулятор 602248 3.7V 650mAh	1	
				РAn91.411711.001		
Зм	Арк.	№ докум.	Підп	Дата		
Розробив	Аристов				Літ.	Аркуш
Перевір.						Аркушів
Т.конт						1
Н.конт	Попсуй				КПІ, РТФ, РА-п91	
Затверд.	Дюжаєв				1	